Fiche Technique

Disponible

Stockage

Samsung SSD 850 EVO



- Technologie V-NAND 3D (32 couches)
- Plus haut niveau de performance en interface SATA III (6 Gb/s)
- Disponible en 120, 250, 500 Go et 1 To

Capacité	120 Go	250 Go	500 Go	1 T0
Basic Kit	MZ-75E120B/EU	MZ-75E250B/EU	MZ-75E500B/E	MZ-75E1T0B/EU
EAN	8806086522946	8806086522977	8806086523035	8806086523042

Technologie V-NAND 3D



Mode Rapid



Garantie 5 ans



Samsung SSD 850 EVO

Caractéristiques principales

Format	2,5''
Utilisation	PC
Interface	SATA 6.0 Gbps
Capacités	120 Go / 250 Go / 500 Go / 1T0
Mémoire	DDR3 SDRAM
NAND FLASH Memory	Samsung 32 Layer 3D V-NAND
Controller	Samsung MGX Controller
Fiabilité (MTBF)	2 million heures
Dimensions (LxPxH)	100x69,85x6,8 (mm)
Poids net	Max 53g (1T0)
Garantie	5 ans
Sécurité	AES 256 bits (class 0) TGC/Opal V2.0, Encrypted drive (IEEE1667)

Performances

Lecture séquentielle	120 Go	540 Mo/s
	250 Go	540 Mo/s
	500 Go	540 Mo/s
	1 To	540 Mo/s
Ecriture séquentielle	120 Go	520 Mo/s
	250 Go	520 Mo/s
	500 Go	520 Mo/s
	1 To	520 Mo/s
Lecture aléatoire (4 KB / QD 32)	120 Go	94 000 IOPS
	250 Go	97 000 IOPS
	500 Go	98 000 IOPS
	1 To	98 000 IOPS
Ecriture aléatoire (4 KB / QD 32)	120 Go	88 000 IOPS
	250 Go	88 000 IOPS
	500 Go	90 000 IOPS
	1 To	90 000 IOPS

Consommations

En marche	2,1 Watt
En veille	0,5 Watt
Norme S.M.A.R.T	Oui
Commande TRIM	Oui
Garbage Collection	Oui
Température en fonctionnement	0°C~70°C
Voltage	5V ± 5%
Choc	1500 G

Contenu

Basic Kit	1 SSD + 1 Garantie
	Magician Software for SSD management

Basic kit

Technologie 3D V-NAND

L'architecture unique et innovante de la mémoire Flash V-NAND 3D de Samsung est une avancée technologique permettant de dépasser les limites de densité, les performances et l'endurance de l'architecture NAND plane traditionnelle. Fabriquée en empilant 32 couches de cellules verticalement au lieu de réduire la taille des cellules et de s'inscrire dans un espace horizontal fixe, la V-NAND 3D permet d'augmenter la densité ainsi que les performances tout en limitant son empreinte.



Turbowrite

Grâce à la technologie Turbowrite de Samsung, vous obtenez des performances optimales en matière de lecture et d'écriture et par conséquent, vous maximiser votre utilisation informatique au quotidien. En plus d'une expérience utilisateur 10% supérieure à celle du 840 EVO*, vous obtenez également des vitesses d'écriture aléatoires jusqu'à 1,9 fois plus rapides. Ceci est aussi valable pour les modèles 120/250 Go**. Le 850 EVO offre les meilleures performances en ce qui concerne les vitesses de lecture (540 Mo/s) et d'écriture (520Mo/s) séquentielles. De plus, vous obtenez des performances aléatoires optimisées pour toutes les profondeurs de file d'attente en cas d'utilisation d'un PC Client.

**PC Mark7 (250Go) : 6700 (840 EVO) > 7600 (850 EVO)*

***Ecriture aléatoire (profondeur de file d'attente : 32 , 120 Go) : 36 000 IOPS (840 EVO) > 88 000 IOPS (850 EVO)*



Mode Rapid

Passez à la vitesse supérieure avec le mode RAPID amélioré.

Accélérez vos performances à tout moment avec le logiciel Samsung Magician qui offre le RAPID mode pour un traitement des données 2 fois plus rapides* au niveau du système. Pour ce faire, celui-ci utilise la mémoire libre du PC (DRAM) comme stockage cache. Tandis que l'utilisation de la mémoire maximale en RAPID mode était de 1Go dans la version précédente du 840 EVO, le nouveau Magician la fait passer à 4 Go fans le 850 EVO grâce à l'application d'une mémoire DRAM de 16 Go. Vous doublez également vos performances* dans toutes les profondeurs de file d'attente aléatoires.

**PCMark 7 RAW (250Go) : 7 500 > 15 000 (RAPID MODE)*



*IOPS : Input-Output Operation per second

*MTBF : Mean Time Between Failures : indique la fiabilité d'un produit ou d'un système

* S.M.A.R.T : Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, fonction destinée à améliorer la fiabilité et à prévenir les pannes